

深圳市晶导电子有限公司

QVAN65F

ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd. POWER MOSFET

650V N-Channel VDMOS 使用及贮存时需防静电 符合 RoHS 等环保指令要求

1. 主要用途

主要用于 LED驱动、电源适配器 等各类功率开关电路

2. 主要特点

- I 开关速度快
- I 通态电阻小,输入电容小

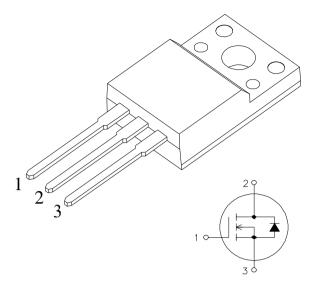
3. 封装外形

TO-220FH

4. 电特性

4.1极限值

除非另有规定, T_{amb}= 25



1 栅极 (G) 2 漏极 (D) 3 源极 (S)

参 数 名 称	符号	额定值	单位	
漏极-源极电压	$V_{ m DSS}$	650	V	
连续漏极电流	I_{D}	4	A	
漏极脉冲电流	I_{DM}	16	A	
栅源电压	V_{GS}	± 30	V	
单脉冲雪崩能量	E _{AS}	128	mJ	
热阻(结到壳)	R _{JC}	3.57	/W	
耗散功率(Ta=25)	P _{tot}	28	W	
结温	T_{j}	150		
贮存温度	T_{stg}	-55 ~ 150		

4.2 电参数

除非另有规定, T_{amb}= 25

参数名称	符号	河北发州	规 范 值			公
		测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	V_{GS} =0V , I_D =250 μ A	650			V
通态电阻	${ m R_{DSON}}^*$	$V_{GS}=10V$, $I_D=2A$		2	2.5	
阈值电压	$V_{GS(TH)}$	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_{D}=250 \mu A$	2		4	V
漏源漏电流	I_{DSS}	V _{DS} =650V , V _{GS} =0V			25	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$			± 10	μA
源漏二极管正向压降	${\rm V_{SD}}^*$	$I_S=4A$, $V_{GS}=0V$			1.5	V
关断延迟时间	$t_{ m d(off)}$	V_{DD} =250V , I_D =4A	50			ns
		$R_G=25$, $V_{GS}=10V$				
输入电容	C_{iss}	V_{GS} =0V , V_{DS} =25V f =1.0MHZ		470		pF
* 脉冲测试 · tp 300us	2%					

* L=10mH , I_D =4A , T_J = 25



深圳市晶导电子有限公司

ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.



POWER MOSFET

4特性曲线

图 1 安全工作区(直流)

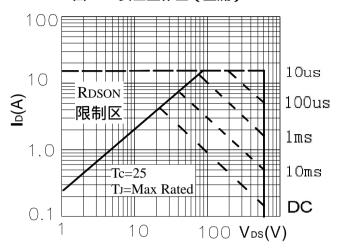


图 2 Ptot-T关系曲线

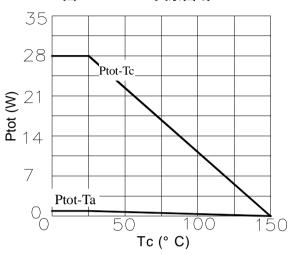


图 3 传输特性曲线

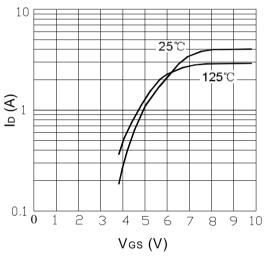


图 4 通态电阻-温度关系曲线

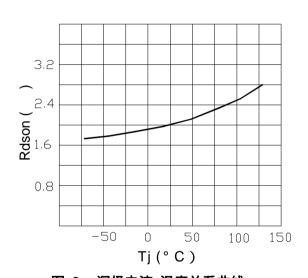


图 5 击穿电压 温度关系曲线

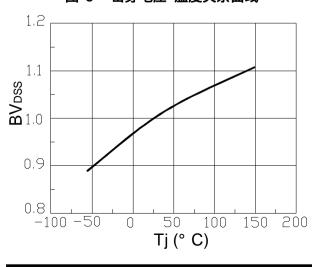
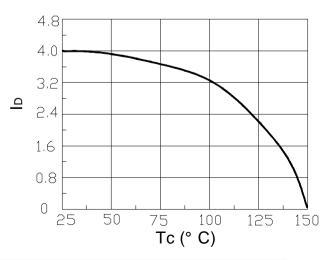


图 6 漏极电流 温度关系曲线



地址:深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园3号厂房 电话:0755-29799516 传真:0755-29799515



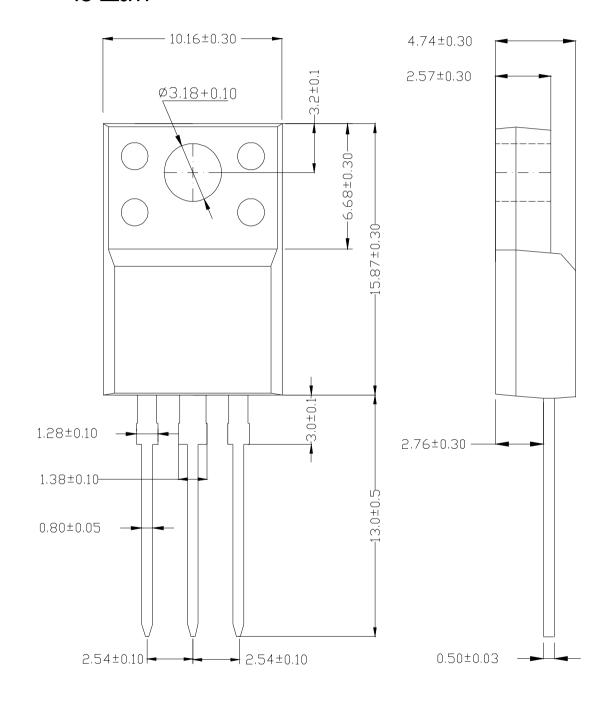
深圳市晶导电子有限公司

OVAN65F POWER MOSFET

ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

6. 产品外形尺寸图 (单位: mm)

TO-220FH



地址:深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园3号厂房 电话:0755-29799516 传真:0755-29799515